

Форма № 18 ИЗ,ПМ-2011



Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАЯВКИ		
Регистрационный номер	Дата подачи	
2023101261/05(002641)	20.01.2023	
Приоритет установлен по дате:		
<input checked="" type="checkbox"/> подачи заявки		
<input type="checkbox"/> поступления дополнительных материалов от к ранее поданной заявке №		
<input type="checkbox"/> приоритета по первоначальной заявке № из которой данная заявка выделена		
<input type="checkbox"/> подачи первоначальной заявки № из которой данная заявка выделена		
<input type="checkbox"/> подачи ранее поданной заявки №		
<input type="checkbox"/> подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции		
(31) Номер первой(ых) заявки(ок)	(32) Дата подачи первой(ых) заявки(ок)	(33) Код страны
1.		
Название изобретения (полезной модели): <input checked="" type="checkbox"/> - как заявлено; <input type="checkbox"/> - уточненное (см. Примечания)		
Способ выращивания кристаллов бестигельным методом и устройство для его реализации		
Заявитель: Гоник Михаил Александрович, RU		
2. ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ		
<input checked="" type="checkbox"/> соблюдено <input type="checkbox"/> не соблюдено. Пояснения: см. Примечания		
3. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ:		
<input checked="" type="checkbox"/> приняты во внимание все пункты		(см. Примечания)
<input type="checkbox"/> приняты во внимание следующие пункты:		
<input type="checkbox"/> принята во внимание измененная формула изобретения		(см. Примечания)
4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ) (Указываются индексы МПК и индикатор текущей версии)		
C30B 13/08 (2006.01)		
C30B 13/18 (2006.01)		
C30B 13/30 (2006.01)		
C30B 13/32 (2006.01)		
C30B 11/00 (2006.01)		
5. ОБЛАСТЬ ПОИСКА		
5.1 Проверенный минимум документации РСТ (указывается индексами МПК)		
C30B 13/00, C30B 13/08, C30B 13/18, C30B 13/20, C30B 13/28, C30B 13/30, C30B 13/32, C30B 11/00		
5.2 Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки:		
см. п. 6		
5.3 Электронные базы данных, использованные при поиске (название базы, и если, возможно, поисковые термины):		
EAPATIS, Espacenet, Google Patents, J-PlatPat, PATENTSCOPE, PatSearch, RUPTO, Science Direct, USPTO, РГБ		
6. ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ПОИСКА		
Категория*	Наименование документа с указанием (где необходимо) частей, относящихся к предмету поиска	Относится к пункту

(см. на обороте)

		формулы №
1	2	3
A	MICHAEL A. GONIK, ARNE CROLL, Silicon crystal growth by the modified FZ technique, CrystEnergComm., 2013, v. 15, p.p. 2287-2293	1-11
A	SU 1800854 A1 (ВНИИ СИНТЕЗА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ), 20.06.1996	1-11
A	RU 2357021 C1 (ООО "ЦЕНТР ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ТЕРМО"), 27.05.2009	1-11
A	RU 2357022 C1 (ООО "ЦЕНТР ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ТЕРМО"), 27.05.2009	1-11
A	RU 2426824 C2 (ГОНИК М.А.), 20.08.2011	1-11
A	US 8834627 B2 (SILTRONIC AG), 16.09.2014	1-11
A	ГОНИК М.А., А. CROLL, К возможности выращивания объемных кристаллов Si-Ge методом осевого теплового потока вблизи фронта кристаллизации, Материалы электронной техники, 2013, no. 3	1-11
A	V.S. YUFEREV, Capillary Shaping of Crystals Pulled Downward from a Melt by the Crucibleless AHP Method, Crystallography Reports, 2008, v. 53, no. 7, p.p. 1214-1220	1-11
A	M.A. GONIK, Potential for growth of Si-Ge bulk crystals by modified FZ technique, J. of Cryst. Growth, 2014, v. 385, p.p. 38-43	1-11
A	F. BALTARETU, M.A. GONIK, Modified FZ technique for oxides crystal growth, J. of Cryst. Growth, 2022, v. 585	1-11

<p>*Особые категории ссылочных документов:</p> <p>«А» документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>«Е» более ранний документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее</p> <p>«L» документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>«О» документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>«Р» документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p> <p>«Т» более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или даты приоритета и не порочащий заявку, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p>		<p>«Х» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска: заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>«У» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска: заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>«&» документ, являющийся патентом-аналогом</p>
7. ПРИМЕЧАНИЯ:		
8. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТЧЕТА		
Настоящий отчет состоит из 2 л.		К отчету приложены копии ссылок на - л. в - экз.
Дата действительного завершения поиска: 23.07.2023		Должность и подпись уполномоченного лица:

Поисковый орган: ФИПС Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 531- 63- 18; e-mail: fips@rupto.ru	ГГЭ Кодинец Н.В.
--	------------------